高色純度青色熱活性化遅延蛍光を示すヘテロ元素架橋 型トリフェニルボランの開発

東北大学大学院 工学研究研究科

助教 北本 雄一

1. はじめに

有機 EL はバックライト不要な自発光に基づいており,低消費電力かつ形状の自由度の高さから,次 世代ディスプレイとして様々な電子機器への搭載がひろがっている.素子の効率化には,電流励起下 で生じる一重項励起子(全体の25%)と三重項励起子(全体の75%)の効率的な利用が鍵となる.近年, 三重項励起状態(T_n)から一重項励起状態(S_n)への吸熱的な変換,すなわち逆項間交差(RISC)後に 蛍光発光を生じる熱活性化遅延蛍光(TADF)が注目を集めている^{1,2}. TADF 分子は,電流励起下で 生じた励起子の 100%を理論上発光として取り出すことが可能である(Figure 1).なかでも,トリフェニル ボランのホウ素に対してオルト位どうしをフェニルイミノ基で架橋した, N,N-架橋型トリフェニルボラン類が,

高色純度な(発光半値幅の狭い)TADF を示すことから^{3,4},高精細ディスプレイの発光材料として期待されている.一方で,合成法に関しては求電子的ボリル化以外の有効なアプローチはほとんど検討されていない⁵.また,工業製品への搭載には,狙いの発光色(特に深青色)・色純度の高さ・RISC の速度,などの複数の光学特性を両立可能なことが求められる.本研究では特に,RISC を損なうことなく深青色の高色純度 TADF を示す新規 *N*,*N*-架橋型トリフェニルボラン類の設計と,求電子的ボリル化に依らない新たな合成法の確立について検討した⁶.



2. 量子化学計算を併用した分子設計

RISC の速度定数 (k_{RISC})は、一般的には式 1 で表現されることが知られている. 近年、 k_{RISC} を向上さ せる戦略として、例えば含 BN 骨格の伸長による $\Delta E(S_1-T_1)$ の縮小や⁴、硫黄原子やセレンなどの導入 による重原子効果を利用したスピンー軌道相互作用の行列要素 (SOCME)の向上などが検討されてい る(Chart 1)^{7,8}. これらのアプローチは HOMO-LUMO ギャップの縮小、すなわち発光波長のレッドシフト も招きやすい. よって、RISC の向上などの光学特性とトレードオフにならず、かつシンプルなアプローチ により深青色発光を可能とする分子設計が望ましい. そこでわれわれは、既報の N,N-架橋型トリフェニ ルボラン類において、ほとんど未開拓な置換基位置に着目した. 具体的には、化合物 1 が有するメトキ シ基の置換位置、すなわちホウ素原子のオルト位の位置である(Chart 1).

 $k_{
m RISC} \propto rac{\langle {f S}_1 | \widehat{H}_{
m SOC} | {f T}_n
angle}{\Delta E({f S}_1 - {f T}_n)}$ (1) $\langle S_1 | H_{soc} | T_n \rangle$:スピンー軌道相互作用 の行列要素 ∆*E*(S₁−Tₙ):S₁とTₙのエネルギー差



高色純度 TADF を示す N,N-架橋型トリフェニルボランの代表例である DABNA を基準構造とし, 種々置換基について検討した. Gaussian を用いた密度汎関数理論 (DFT) により,メトキシ基を導入した 化合物 1 において DABNA よりも大きな HOMO-LUMO ギャップを示しつつ,多重共鳴構造 ³ は維持 していることを見出した (Figure 2a). BIOVIA TURBOMOLE を用いた Coupled Cluster 法である SCS-CC2 法により $\Delta E(S_1-T_1)$ を算出したところ,メトキシ基導入による影響は非常に小さいことがわかった (Figure 2b). また, S₁ に近接する S₁-T₁ 間ならびに S₁-T₂ 間の SOCME は, DABNA よりも 1 のほうが 大きな値を示すことが示唆された. 以上の結果から, 化合物 1 は DABNA よりも深い青色の TADF を示 すと判断した.



3. 三つの C-B 結合の一挙構築による N,N-架橋型トリフェニルボランの合成

化合物1が有するメトキシ基は、リチオ化などのメタル化の配位性配向基であり、オルト位水素を直接 メタル化可能なことが知られている。われわれは、フェニル基上水素のメタ位にエーテル酸素原子を二 つ有するベンゼン三量体に対し、直接トリリチオ化と続くホウ素化によって *0*,*0*-架橋体が得られることを 報告している⁹⁻¹¹.そこで、われわれは、架橋基がフェニルイミノ基であっても配位性配向基として機能す ると予想し、メタ位に配位性配向基としてエーテル基とフェニルイミノ基を有する基質 5 を設計・合成し た.5 を *n*-BuLi で処理した後、ホウ素化試薬と反応させたところ、目的の1 を単離収率 57%で得ること に成功した(Scheme 1).1 はアリール配位子が中心ホウ素に対して三座配位(三つの C-B 結合)した 構造を有することから、ホウ素の立体的な保護無しに空気下で安定に存在する.この安定化の恩恵



を受ける形で、1のメトキシ基の脱保護によるジオール体6への誘導、続くエーテル化によりシリルエーテル体や長鎖エーテル体、架橋体2-4などの合成に成功した.また、5の架橋基の一つをオキソ基に変更した基質や、5のフェニルイミノ基とメトキシフェニル基をカルバゾール様に縮環した基質についても、本合成法により直接リチオ化とホウ素化によって誘導体が合成できることを見出した.

4. 合成した N,N-架橋型トリフェニルボラン類の光学特性の評価

トルエン中,1のUV-Vis吸収スペクトルと蛍光スペクトルを測定したところ,425 nm に極大吸収を有 し, ピークトップを 440 nm に有する半値幅 24 nm の深青色発光を示した(Figure 3a). DABNA は 437 nm と 462 nm (半値幅:33 nm)に極大吸収ピークと蛍光発光ピークをそれぞれ示すことから,分子設計 の狙い通り発光色のブルーシフトに成功したといえる. さらに, ポリメタクリル酸メチル (PMMA) をホストポ リマーとする薄膜中における 1 の発光寿命測定を行ったところ, 5.0 ns の即時発光成分に加え, 50 μs の明確な遅延発光成分が観測された(Figure 3b).この遅延成分には温度依存性がみられたことから, メトキシ基を導入した1 においても TADF 性が失われていないことが明確に確認できた. この TADF 性 は化合物 2-4 についても維持されている.時定数や絶対発光量子収率の値から k_{RISC} を算出したとこ ろ, 1 (2.7×10⁴ S⁻¹ in PMMA) や 2 (3.2×10⁴ S⁻¹ in PMMA) などは DABNA (0.99×10⁴ S⁻¹ in mCBP) よりも速い RISC を示す傾向にあるだけでなく, 4 では 3.9 × 104 S⁻¹という1よりも速い RISC を示した. 国際電気通信連合無線通信部門(ITU-R)の勧告 BT.2020 において, 超高精細テレビジョン(UHDTV) に求められる青色の色度座標は, CIE (国際照明委員会) が開発した CIE1931 色度座標で表現すると CIE (x,v) = (0.131, 0.046) であることが定められている¹². 化合物1と2の PMMA 薄膜中における発 光スペクトルを色度座標に変換したところ,それぞれ (0.149,0.044) と (0.142,0.063) という値が得ら れた. したがって, 化合物 1-4 は, 特に CIE, を満たす深青色 TADF を示すという特徴的な性質を有し ていることが明らかとなった.





5. まとめ

本研究では、エーテル基の導入による高色純度青色 TADF 化合物の分子設計、ならびにエーテル 基を含む配位性配向基を利用した三つの C-B 結合の一挙構築法の開発に成功した.本分子設計は シンプルでありながら、従来の TADF 特性を損なうことなく深青色発光を実現可能である.また、分子設 計の要となる官能基は、合成法においても新たなアプローチを可能とする起点となっていることから、新 たな化合物群の合成が期待できる.現在,他の含 BX 骨格(X = N,O,S など)への展開や,ヒドロキシ基 を起点とする光学特性の向上などにも着手しており,従来の合成法において未開拓な分子設計への展 開やデバイス搭載への展開が期待される.

謝辞

本研究成果は,研究協力者である学生諸氏のたゆまぬ努力によって得られたものであり,ここに感謝 の意を表します.また,本研究を遂行するにあたり,公益社団法人天野工業技術研究所に多大なご支 援をいただきました.ここに記して謝意を示します.

参考文献

- 1) H. Uoyama, K. Goushi, K. Shizu, H. Nomura, C. Adachi, Nature 2012, 492, 234.
- 2) H. Nakanotani, Y. Tsuchiya, C. Adachi, Chem. Lett. 2021, 50, 938.
- 3) T. Hatakeyama, K. Shiren, K. Nakajima, S. Nomura, S. Nakatsuka, K. Kinoshita, J. Ni, Y. Ono, T. Ikuta, *Adv. Mater.* 2016, 28, 2777.
- 4) Y. Kondo, K. Yoshiura, S. Kitera, H. Nishi, S. Oda, H. Gotoh, Y. Sasada, M. Yanai, T. Hatakeyama, *Nat. Photon.* 2019, 13, 678.
- 5) M. Mamada, M. Hayakawa, J. Ochi, T. Hatakeyama, Chem. Soc. Rev. 2024, 53, 1624.
- 6) Y. Kitamoto *et al.*, to be submitted.
- 7) I. S. Park, M. Yang, H. Shibata, N. Amanokura, T. Yasuda, Adv. Mater. 2022, 34, 2107951.
- 8) I. S. Park, H. Min, T. Yasuda, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202205684.
- 9) Y. Kitamoto, S. Oi et al., Chem. Commun. 2016, 52, 7098.
- 10) Y. Kitamoto, T. Hattori, S. Oi, Chem. Commun. 2022, 57, 2297.
- 11) Y. Kitamoto, T. Hattori, S. Oi, J. Org. Chem. 2023, 88, 5852.
- 12) https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2020-2-201510-I/en